

Date of birth: **Nationality:** Italian **Gender:** Male

IOM-CNR, AREA Science Park Basovizza, SS 14, Km 163,5, 34149, Trieste, Italy

● WORK EXPERIENCE

15/10/2020 – CURRENT – Trieste, Italy

RESEARCH DIRECTOR – CNR-IOM, LABORATORIO TASC

Direction of the high mobility MBE (Molecular Beam Epitaxy) and magnetotransport laboratories at the IOM-CNR Institute in Trieste, Italy.

<https://www.iom.cnr.it/high-mobility-molecular-beam-epitaxy-hm-mbe> |

AREA Science Park Basovizza, 34149, Trieste, Italy

01/01/2010 – 14/10/2020

SENIOR DEVELOPMENT SCIENTIST-TECHNOLOGIST – CNR-IOM, LABORATORIO TASC

Direction of the high mobility MBE (Molecular Beam Epitaxy) and magnetotransport laboratories at the IOM-CNR Institute in Trieste, Italy.

<https://www.iom.cnr.it/high-mobility-molecular-beam-epitaxy-hm-mbe> |

AREA Science Park Basovizza, 34149, Trieste, Italy

01/12/2001 – 31/12/2009

DEVELOPMENT SCIENTIST-TECHNOLOGIST – CNR-IOM, LABORATORIO TASC

Management of the high mobility MBE (Molecular Beam Epitaxy) and magnetotransport facilities at the TASC IOM-CNR Lab in Trieste, Italy.

AREA Science Park Basovizza, 34149, Trieste, Italy

15/08/1999 – 30/11/2001

POST-DOC FELLOW – LABORATORIO NAZIONALE TASC INFM

Growth and characterization of high-mobility III-V semiconductors

AREA Science Park Basovizza, 34149, Trieste, Italy

01/08/1998 – 01/09/1999

SCIENTIFIC COLLABORATOR – DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE, ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

Epitaxial growth and characterization of semiconductor nanostructures

PH-Ecublens, 1015, Lausanne, Switzerland

01/08/1994 – 31/07/1998

GRADUATE STUDENT - ASSISTANT – DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE, ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

Epitaxial growth and characterization of semiconductor nanostructures, teaching assistant in Physics diploma courses.

PH-Ecublens, 1015, Lausanne, Switzerland

17/05/1994 – 30/06/1995

HONORARY FELLOW – SYNCHROTRON RADIATION CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN

Synchrotron radiation photoelectron spectroscopy

3731 Schneider Dr., 53589, Stoughton, WI, United States

01/08/1992 – 31/07/1994

RESEARCH SPECIALIST – DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE, UNIVERSITY OF MINNESOTA

Synchrotron radiation and X-ray photoemission spectroscopy

421 Washington Ave. SE, 55455, Minneapolis, MN, United States

● **EDUCATION AND TRAINING**

01/08/1994 – 13/11/1998 – Lausanne, Switzerland

PH.D. IN PHYSICS – Département de Physique, École Polytechnique Fédérale

Epitaxial growth of semiconductors, atomic force microscopy, micro-nanofabrication of semiconductors

Field(s) of study

- Physical sciences

01/10/1986 – 10/07/1992 – Trieste, Italy

BACHELOR DIPLOMA IN PHYSICS (SCORE 110/110 WITH HONOURS) – Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Trieste

Epitaxial growth of semiconductors, X-ray photoemission spectroscopy

Field(s) of study

- Physical sciences

01/10/1981 – 15/06/1986 – Monfalcone (GO), Italy

SCIENTIFIC HIGH SCHOOL DIPLOMA (SCORE 60/60) – Liceo Scientifico “Michelangelo Buonarroti”

● **PUBLICATIONS**

Excitons bound by photon exchange

Nature Physics (in press).

<https://doi.org/10.1038/s41567-020-0994-6> – 2020

E. Cortese, L. Tran, J.-M. Manceau, A. Bousseksou, I. Carusotto, G. Biasiol, R. Colombelli, and S. De Liberato

First observation of the quantized exciton-polariton field and effect of interactions on a single p

Science Advances 4, eaao6814 (2018)

<https://doi.org/10.1126/sciadv.aao6814> – 2018

A. Cuevas, B. S. Fernández, J. C. López Carreño, M. de Giorgi, C. S. Muñoz, A. Fieramosca, D. S. Forero, F. Cardano, L. Marrucci, V. Tasco, G. Biasiol, E. del Valle, L. Dominici, D. Ballarini, G. Gigli, P. Mataloni, F. Sciarrino, and D. Sanvitto

Perfect energy feeding into strongly coupled systems: polaritonic coherent perfect absorption

Nature Physics 10, 830 (2014)

<https://dx.doi.org/10.1038/nphys3106> – 2014

S. Zanotto, F. Mezzapesa, F. Bianco, G. Biasiol, L. Baldacci, M. Vitiello, L. Sorba, Raffaele Colombelli, and A. Tredicucci

Imaging Fractional Incompressible Stripes in Integer Quantum Hall Systems

Phys. Rev. Lett. 108, 246801 (2012)

<https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.246801> – 2012

N. Paradiso, S. Heun, S. Roddaro, L. Sorba, F. Beltram, G. Biasiol, L. N. Pfeiffer and K. W. West

Compositional Mapping of Semiconductor Quantum Dots and Rings

Physics Reports 500, 117 (2011)

<https://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2010.12.001> – 2011

G. Biasiol and S. Heun

Correlation-Induced Single Flux-Quanta Penetration in Quantum Rings

Nature Physics 6, 173 (2010)

<https://dx.doi.org/10.1038/nphys1517> – 2010

J. M. Giesbers, U. Zeitler, M. I. Katsnelson, D. Reuter, A. D. Wieck, G. Biasiol, L. Sorba, and J.C. Maan

Sub-cycle switch-on of ultrastrong light-matter interaction

Nature 458, 178 (2009)

<https://dx.doi.org/10.1038/nature07838> – 2009

G. Günter, A. A. Anappara, J. Hees, L. Sorba, G. Biasiol, S. De Liberato, C. Ciuti, A. Tredicucci, A. Leitenstorfer, and R. Huber

Rabi splitting of intersubband cavity polaritons

Phys. Rev. Lett. 90, 116401 (2003)

<https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.90.116401> – 2003

D. Dini, R. Köhler, A. Tredicucci, G. Biasiol, L. Sorba, and F. Beltram

Mechanisms of self-ordering of quantum nanostructures grown on nonplanar surfaces

Phys. Rev. Lett. 81, 2962 (1998)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.2962> – 1998

G. Biasiol and E. Kapon

Microscopic Capacitors and Neutral Interfaces in III-V/IV/III-V Semiconductor Heterostructures

Phys. Rev. Lett. 69 (8), 1283 (1992)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.69.1283> – 1992

G. Biasiol, L. Sorba, G. Bratina, R. Nicolini, A. Fanciosi, M. Peressi, S. Baroni, R. Resta, and A. Baldereschi

● PROJECTS

01/04/2019 – CURRENT

FET OPEN "AndQC (Andreev qubits for scalable quantum computation)"

IOM CNR coordinator

05/02/2017 – 04/02/2020

PRIN 2015 "Rivelatori di raggi X in semiconduttori ad alto numero atomico per sorgenti di nuova ge"

IOM CNR coordinator

01/01/2017 – CURRENT

FET OPEN "MIR-BOSE (Mid- and far-IR optoelectronic devices based on Bose-Einstein condensation)"

CNR coordinator

● HONOURS AND AWARDS

Honours and awards

Winner of the "Young Author Best Paper Award", 24th International Conference on the Physics of Semiconductors, Jerusalem (Israel), August 2-7, 1998.

● WORK ACTIVITY

Responsibilities

As head of the Leader of the HMMBE group (High Mobility Molecular Beam Epitaxy) at IOM-CNR, consisting normally of three to five people, I am involved in several projects aimed both to basic science and to technological innovation, in fields such as photonics, development of semiconductor nanostructures, coherent transport, biosensors, spintronics, plasmonics, large infrastructures support (Elettra Synchrotron), surface science.

My main activity consists both in the technical management of the lab and in the development of materials and devices, in collaboration with Italian and international researchers working in the above-mentioned fields, within common projects or commercial contracts.

These competences led me to join various advisor and strategic panels within national and international institutions.

Achievements

- Coordinator/local coordinator for 9 National research projects, 2 EU H2020 project and 4 commercial contracts.
- Involved in more than 20 National and European research projects and commercial contracts.
- Member of the International Foresight Science & Technology Group of the Italian National Research Council (CNR).
- Delegate of the IOM-CNR Institute at the Italian Technological Platform for Photonic Sources and Sensors.
- Expert Pool member of the European Photovoltaic Technology Platform.
- Expert evaluator for: ENI CBC-MED ERA-NET, Italian MIUR and MiSE, FNRS and FWO (Belgium), COST, NKFIH (Hungary), TACR (Czech).
- Member of the teachers board, Doctorate School in Nanotechnology, University of Trieste, Italy.
- Co-organizer of the 18th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, March 2015.
- Member of the Editorial Boards of: Journal of Materials Science & Nanotechnology (AnnexPublishers, USA), International Journal of Material Science (World Academic Publishing); DatasetPapers in Condensed Matter Physics (Hindawi Publishing Corp.), Materials (MDPI Publisher), AppliedSciences (MDPI Publisher), International Journal of Physics (MDPI Publisher)
- Guest Editor, Materials (MDPI Publisher); special issue "Epitaxial Materials"
- Editorial Referee for over 20 ISI journals

● BIBLIOMETRIC INFORMATION

Bibliometric information

Author of more than 180 papers on peer reviewed international journals and 5 invited papers and book chapters.

h-index: 28 (Scopus), 27 (ISI-WoS), 33 (Google Scholar)

ORCID:<http://orcid.org/0000-0001-7974-5459>

ResearcherID: C-5465-2009,<http://www.researcherid.com/rid/C-5465-2009>

Google Scholar:<http://scholar.google.it/citations?user=HrGAeroAAAAJ&hl=it&oi=ao>

● PATENTS

Patents

"Position and mass detector by means of surface acoustic waves", Italian National Patent (2011)

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA MBE DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL'ISTITUTO NANOSCENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL "Progetto infrastrutture PASQUA" CUP B55J19000360001, IMPORTO COMPLESSIVO € 1.050.000,00

CIG – 8648445A94

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Giorgio Biasiol, nato a ##### (##) il #####, con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente **effettivo o supplente** della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici:
 - Assing S.p.A. con sede legale in Via Edoardo Amaldi 15, 00015 Monterotondo (RM) codice fiscale 06725640582 partita IVA 01603091008;
- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) L'assenza¹ delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data 23/04/2021

¹ **Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse)** Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Curriculum Vitae Dr. Stefan Heun

Summary:

Work address: NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore
Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa, Italy
phone office: +39-050-509 472
FAX: +39-050-509 550

E-mail: stefan.heun@nano.cnr.it

WWW: <http://web.nano.cnr.it/heun/>

Present position: Research Director at CNR - Istituto Nanoscienze, Pisa, Italy.

Language skills: German (native), English (fluent), Italian (fluent), Japanese (basic knowledge)

Research areas: My main research interest is the physics of low-dimensional systems. Using a combination of scanning probe microscopies and low-temperature magneto-transport, we investigate quantum effects (quantum Hall effect, weak localization, anisotropic magneto-transport, Josephson junctions) and surface phenomena relevant for applications (hydrogen storage, defect characterization, surface functionalization, metal intercalation) in III-V 2DEGs, graphene, and exfoliated few-layer black phosphorus.

Publications: Over 160 publications in refereed international journals and more than 110 invited presentations and seminars. My papers have been cited more than 3300 times. **h- index: 31** (source: Web of Science, April 2021).

Education:

02/1993: Ph.D. in Physics from the University of Hannover, Germany, supervisor: Prof. Dr. M. Henzler, thesis: *The electrical conductivity of thin films of Ag, Pb, and Au on Si(111)*. [[link](#)] [[thesis](#)]

10/1989: Diploma in Physics from the University of Hannover, Germany, supervisor: Prof. Dr. M. Henzler, thesis: *The initial stages of epitaxial growth of silicon on Si(100)-2x1*. [[link](#)] [[thesis](#)]

Employment/Appointments:

Since 10/2020: Research Director at CNR - Istituto Nanoscienze, Pisa, Italy.

Since 10/2018: Adjunct Professor at the Department of Civil and Industrial Engineering of the University of Pisa, Italy.

Since 10/2015: Adjunct Professor at Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy.

Since 10/2006: Senior Scientist at CNR - Istituto Nanoscienze, Pisa, Italy.

04/2004 – 10/2006: Senior Scientist at CNR - Istituto Nazionale per la Fisica della Materia at the Laboratorio Nazionale TASC, Trieste, Italy.

07/1997 – 03/2004: Beam line scientist at Sincrotrone Trieste, Italy.

- 06/1995 – 07/1997: Postdoc in the Materials Division of the Laboratorio TASC-INFN, Trieste, Italy.
- 11/1993 – 05/1995: Post-doctoral Fellow at the Interdisciplinary Research Laboratories of the Japanese Telecom NTT, Tokyo, Japan.
- 01/1990 – 10/1993: Research Scientist at University of Hannover, Germany.

Awards:

- 06/2016: Eligible (*idoneo*) for Director of Research, see Graduatoria CNR 364.172 DSFTM [[link](#)] and 364.172 DSCTM [[link](#)].
- 12/2013: Habilitation for full professor, awarded by the Italian Ministry of Education, University, and Research (Abilitazione Scientifica Nazionale, 02/B1 – 1 Fascia). [[link](#)]
- 06/1995 – 07/1997: TMR Marie Curie research fellowship of the Commission of the European Communities.

Responsible of research grants:

- 2017: Italian coordinator of project *Optoelectronics in graphene-based heterostructures* within the agreement CNR – NRF South Korea (Korean partner: Prof. Jeil Jung, University of Seoul, original Italian proposer: A. Tomadin), total 16 kEuro. CNR Anagrafica SAC.AD002.008.006
- 2016 – 2018: Internal project of Scuola Normale Superiore on *Phosphorene: a new platform for advanced multifunctional devices*, total 19 kEuro, project code SNS16_B_HEUN_004155 (SNS Repertorio 334/2016).
- 2016 – 2018: Italian coordinator of project *Electron interferometry with scanning probe microscopy in graphene* within the program for scientific and technological cooperation between the Italian Republic and the Republic of Poland (Polish partner: Prof. B. Szafran), total 6 kEuro. [[link](#)]
- 2015 – 2019: Responsible at CNR-Nano of the ERC Advanced Grant *Phosfun* (grant agreement no. 670173), PI Maurizio Peruzzini, duration: from 01/07/2015 to 01/07/2019. [[link](#)] CNR Anagrafica DCM.AD001.167.003, Provvedimento Nr. 160/2015, Protocollo 3512 del 03/08/2015.
- 2015 – 2016: Obtained 2 CNR Short Term Mobility Grants to host Prof. Guillaume Gervais (McGill University, Montreal, Quebec, Canada) in Pisa, total 5000 Euro.
- 2014 – 2015: Received 2 STSM Travel grants from COST Action MP1103 for one-week stays at IBM Zurich Research Laboratories, total 2400 Euro.
- 2014 – 2015: Italian coordinator of project *High-mobility graphene monolayers for novel quantum devices* within the agreement CNR – JSPS (Japanese partner: Dr. S. Suzuki, NTT Basic Research Laboratories), total 16 kEuro. CNR Anagrafica SAC.AD002.012.002
- 2013 – 2015: Italian coordinator of project *Nanoélectronique quantique pour les technologies de l'information* within the program of scientific and

technological cooperation between the Italian Republic and Canada - Quebec (Canadian partner: Prof. G. Gervais), total 70 kEuro. [[link](#)] CNR Anagrafica DFM.AD003.145, lettera accettazione contributo: 1987/2015.

- 2008 – 2010: Italian coordinator of project MST *Spectroscopic investigations of dip pen nanolithography patterns* within the program of scientific and technological cooperation between the Italian Republic and the Republic of India (Indian partner: Prof. C. N. R. Rao), total 24 kEuro. [[link](#)]
- 2008 – 2010: Italian coordinator of project MST4 *Innovative catalytic patterns for nanowire growth* within the program of scientific and technological cooperation between the Italian Republic and the Republic of India (Indian partner: Prof. G. U. Kulkarni), total 24 kEuro. [[link](#)]
- 2006: Obtained CNR Short Term Mobility Grant to host Prof. Federico Rosei (INRS-EMT, Varennes (QC), Canada) in Trieste, total 1000 Euro.
- 2005 – 2007: Italian coordinator of project MST1 *Spectroscopic investigations of dip pen nanolithography patterns* within the program of scientific and technological cooperation between the Italian Republic and the Republic of India (Indian partner: Prof. C. N. R. Rao), total 24 kEuro. [[link](#)]

Responsible of research infrastructure:

- Since 2010: Responsible of the Variable-temperature Scanning Tunneling Microscopy laboratory at the NEST lab in Pisa (from 25/06/2010). This includes purchase of the equipment, setup of the lab, and supervision of students and postdocs. [[doc](#)]
- Since 2007: Responsible of the Scanning Gate Microscopy laboratory at the NEST lab in Pisa (from 01/10/2007). This includes purchase of the equipment, setup of the lab, and supervision of students and postdocs. [[doc1](#)] [[doc2](#)]
- 2002 – 2005: Responsible for the Nanospectroscopy beamline and the SPELEEM microscope at Elettra (from 01/02/2002 to 31/05/2005), which includes the responsibility for the staff (1 researcher, 1 technician) and the operation and budget of the beamline (approximately 10 external user groups per semester). Annual budget: approx. 50 kEuro. [[doc](#)]

Board memberships:

- 2019, 2021: Member of the PhD Selection Committee in Nanoscience of Scuola Normale Superiore
- Since 2016: Member of the Consiglio di Istituto of the Istituto Nanoscienze-CNR. Provvedimento CNR Nano N. 127/2017.
- Since 2014: Official Nominator for the Japan Prize
- Since 2010: Member of several selection committees of CNR: Bandi Nano AR 009/2010 PI, Nano AR 025/2011 PI, Nano 006/2014 MO, Nano 002/2015 PI, Nano 001/2016 PI, Nano 004/2016 PI, Nano 008/2016 PI, Nano 009/2016 PI, Nano 012/2016 PI, Nano 016/2016 PI, Nano AR 007/2016 PI, Nano 007/2017 PI, Nano 008/2017 PI, Nano 011/2017 PI,

Nano AR 002/2017 PI, Nano AR 003/2017 PI, Nano AR 007/2017 PI,
Nano BS 002/2017 PI, Nano 380.8 RIC, Nano AR 028/2020 PI.

- Since 2010: Member of several selection committees of Scuola Normale Superiore: SNS Bandi n. 669 (2010), 638 (2011), 607 (2012), 520 (2015), 574 (2016), 95 (2018), 554 (2019).
- 2005 – 2012: Member of the Board of Delegates of the European Materials Research Society (E-MRS).
- 2001 – 2006: Member of several selection committees of the Istituto Nazionale per la Fisica della Materia: INFN Bandi n. 500r (2001), 588 (2002), 675 (2002), 860 (2003), 1004 (2006).

Refereeing activities:

- 2020: Proposal referee for the Austrian Science Fund FWF.
- 2020: Proposal referee for the Dutch Research Council NWO.
- 2019: Proposal referee for the ANR French National Research Agency.
- Since 2018: Proposal referee for [CERIC-ERIC](#).
- 2018 – 2019: Proposal referee for the GIF German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development.
- 2016: Proposal referee for the DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft.
- Since 2014: Proposal referee for Elettra Sincrotrone Trieste, Italy [[link](#)].
- 2014 – 2020: Proposal referee for the ERC Starting Grant (in 2014 and 2020).
- 2014 – 2019: Expert evaluator for the Italian Ministry of Economic Development (MISE). CNR Anagrafica SAC.AD002.029.077, Protocollo CNR Nano n. 7421 del 09/12/2014.
- 2014 – 2016: Proposal referee for the Center for Functional Nanomaterials, Brookhaven National Laboratories, Upton, NY, USA.
- 2012 – 2016: Referee for ANVUR VQR 2004 – 2011, Protocollo MIUR n. 160/Ric del 28/02/2012; Referee for ANVUR VQR 2011 – 2014, Protocollo CNR Nano n. 4872 del 22/12/2016.
- 2011: Expert evaluator of FIRB *Futuro in Ricerca* proposals for the Italian MIUR.
- 2010 – 2015: Expert evaluator of People Marie Curie Individual Actions for the FP7 programme of the European Union (2010 – 2011); of People Marie Curie Individual Actions for the H2020 programme of the European Union (2015).
- 2010 – 2012: Proposal referee for the Canadian Light Source.
- 2009 – 2015: Proposal referee for the Swiss Light Source, Villigen, Switzerland.
- Since 2006: Evaluator for the PhD theses of K. S. Joseph Wilson, Madurai Kamaraj University, India (2006); Manoj Kesaria, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore, India (2012); Alessandro De

Cecco, Université Grenoble Alpes, France (2018). Evaluator of the MSc thesis of Romar Angelo M. Avila, Erasmus Mundus Joint Master Degree (SERP+) (2020).

2002 – 2006: Proposal referee for the Academy of Sciences of the Czech Republic.

Since 1997: Manuscript referee for numerous international journals: Nature Physics, ACS Nano, Nano Letters, Nature Communications, Physical Review Letters, and others. [[Publons](#)]

Editorial board memberships:

2020: Guest editor of a special issue of Phys. Status Solidi RRL, Volume 14, Issue 2, February 2020, on two-dimensional semiconductors. [[link](#)]

2010: Guest editor of a special issue of Nuclear Instruments and Methods B: Vol. 268, February 2010. [[link](#)]

Since 2009: Member of the Editorial Board of the International Journal of Nanoscience. [[link](#)]

2008 – 2013: Member of the Editorial Advisory Board of The Open Condensed Matter Physics Journal.

2008: Co-editor of the book *Beam injection based nanocharacterization of advanced materials*, Research Signpost, Trivandrum, Kerala, India, 2008, ISBN: 978-81-308-0226-8. [[link](#)]

2006: Guest editor of a special issue of Nuclear Instruments and Methods B: Vol. 246, May 2006. [[link](#)]

2003: Guest editor of a special issue of Nuclear Instruments and Methods B: Vol. 200, January 2003. [[link](#)]

2002: Co-editor of the book *Nanoscale Spectroscopy and Its Applications to Semiconductor Research*, Lecture Notes in Physics, Vol. 588, Springer Verlag, 2002, ISBN: 978-3-540-43312-5. [[link](#)]

Conference organization:

2019: Member of the Organizing Committee of the Nanowire Week 2019 Conference, 23 – 27 September 2019, in Pisa, Italy. [[link](#)]

2019: Co-organizer of symposium T on *2D semiconductors: applications and perspectives* at the E-MRS Spring Meeting, 27 – 31 May 2019, in Nice, France. [[link](#)]

2018: Member of the Program Committee of the *3rd Meeting of the Nanoscience Institute – CNR Nano*, 29 – 30 October 2018, in Pisa, Italy. [[link](#)]

2017: Member of the International Advisory Committee of the *9th International Workshop on Nanoscale Spectroscopy and Nanotechnology*, 25 – 28 September 2017, in Gyeongju, South Korea.

2015: Co-organizer of *Fosforene Day*, 17 July 2015, in Florence, Italy.

- 2014: Member of the International Advisory Committee of the *8th International Workshop on Nanoscale Spectroscopy and Nanotechnology*, 28 - 31 July 2014, in Chicago, USA.
- 2012: Organizer of *Graphene Day: fundamentals, electronics, renewable energy*, 9 – 10 July 2012, in Pisa, Italy. [[link](#)]
- 2012: Member of the International Advisory Committee of the *7th International Workshop on Nanoscale Spectroscopy and Nanotechnology*, 2 - 6 July 2012, in Zurich, Switzerland.
- 2011: Member of the Scientific Committee of Symposium M of the *E-MRS ICAM IUMRS Conference*, 9 - 13 May 2011, in Nice, France.
- 2010: Member of the International Advisory Committee of the *6th International Workshop on Nanoscale Spectroscopy and Nanotechnology*, 25 - 29 October 2010, in Kobe, Japan. [[link](#)]
- 2009: Co-organizer of the symposium *X-ray Techniques for Advanced Materials, Nanostructures and Thin Films: from Laboratory Sources to Synchrotron Radiation* at the E-MRS Spring Meeting, 8 - 12 June 2009, in Strasbourg, France.
- 2008: Member of the International Advisory Committee of the *Fifth International Workshop on Nanoscale Spectroscopy and Nanotechnology*, 15 - 19 July 2008, in Athens, Ohio, USA.
- 2006: Member of the International Programme Committee of the *Fourth International Workshop on Nanoscale Spectroscopy and Nanotechnology*, 17 - 21 September 2006, in Rathen, Germany.
- 2005: Co-organizer of the symposium *Synchrotron Radiation and Materials Science* at the E-MRS Spring Meeting, 31 May - 3 June 2005, in Strasbourg, France.
- 2004: Member of the International Programme Committee of the *Third International Workshop on Nanometer Scale Spectroscopy and Nanotechnology*, 10 - 14 December 2004, at the University of Maryland, College Park, USA.
- 2002: Co-organizer of the symposium *Synchrotron Radiation and Materials Science* at the E-MRS Spring Meeting, 18 - 21 June 2002, in Strasbourg, France.
- 2002: Member of the Conference Committee of the *Second International Workshop on Nano-scale Spectroscopy and Nanotechnology*, 25 - 29 November 2002, in Tokyo, Japan.
- 2000: Secretary of the Organizing Committee of the *First International Workshop on Nano-scale Spectroscopy and its Applications to Semiconductor Research*, 11 - 14 December 2000, in Trieste, Italy. [[link](#)]

Teaching experience:

- Since 2018/2019: Lectures (36 hours/year) in the course “Nanostructured Materials” of the Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Università di Pisa, Italy.

- Since 2015/2016: Lectures (20 hours/year) in the course “Materiali Nanostrutturati” of Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy. [[link](#)]
- 2014/2015: Lectures (10 hours) in the course “Materiali Nanostrutturati” for PhD students of Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy.
- 2014: Lecture (1 hour) at the International School on *New frontiers in down-scaled materials and devices: realization and investigation by advanced methods*, Otranto, Italy, 15 – 20 September 2014. [[Lecture](#)]
- 2014: Lectures (4 hours) at the post-graduate course on *Graphene* at the University of Modena and Reggio Emilia, Italy, 18 – 19 June 2014. [[Lecture](#)]
- 2011: Lectures (2 hours) at the 13th International Conference - School on Advanced Materials and Technologies, Palanga, Lithuania, 27 - 31 August 2011. [[Abstract](#)] [[Lecture](#)]
- 2008: Lecture (1 hour) at the Winter School on Synchrotron Radiation, Delmenhorst, Germany, 12 – 14 November 2008. [[Lecture](#)]
- 2006: Lectures at the post-graduate course on *Advanced Microscopy* at the University of Trieste, Italy. [[link](#)]
- 1999: 2 hours of lectures on *Spectromicroscopy at Elettra* at the University of Calabria, Cosenza, Italy (Prof. E. Colavita), 18 - 19 October 1999.
- 1990 – 1993: Tutor in the students’ laboratory at the Physics department of the University of Hannover, Germany.

Student supervision:

- 2019 – 2020: G. Cappelli: *Quantum Transport in planar Niobium/black-Phosphorus/Niobium Junctions*, Master thesis, University of Pisa, Italy. [thesis] [defense talk]
- 2019 – 2020: L. Ferbel: *Surface reconstructions induced by Rb on Si(111)*, Master thesis, University of Pisa, Italy. [thesis] [defense talk]
- 05 – 07/2018: Marion Bonhomme, Exchange student from [INP-Phelma](#), Grenoble, France. [[Report](#)] [[Presentation](#)]
- 05 – 07/2017: Gwenael Le Gal, Exchange student from [INP-Phelma](#), Grenoble, France. [[Report](#)] [[Presentation](#)]
- 05 – 07/2017: Zoe Dubois, Exchange student from [INP-Phelma](#), Grenoble, France.
- 2016 – 2017: S. Fiori: *Li-functionalized graphene on silicon carbide*, Master thesis, University of Pisa, Italy. [[thesis](#)] [[defense talk](#)]
- 2015 – 2019: Abhishek Kumar: *Black Phosphorus: Pristine and doped surface investigations using Scanning Tunneling Microscopy*, PhD thesis, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy. [[thesis](#)] [[defense talk](#)]
- 2015 – 2016: L. Bours: *Edge channel transport in graphene nanoribbons*, Master thesis, Radboud University Nijmegen, The Netherlands. [[thesis](#)] [[defense talk](#)]

- 05 – 07/2015: Luca Planat, Exchange student from [INP-Phelma](#), Grenoble, France. [[Report](#)]
- 2013 – 2014: S. Guiducci: *Electron transport and scanning gate microscopy studies on ballistic hybrid SNS junctions*, Master thesis, University of Pisa, Italy. [[thesis](#)]
- 2010 – 2014: S. Goler: *Graphene for hydrogen storage*, PhD thesis, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy. [[thesis](#)] [[defense talk](#)]
- 2010 – 2011: T. Mlakar: *Conductive atomic force microscopy investigations of quantum dots and quantum rings*, Master thesis, University of Nova Gorica, Slovenia. [[thesis](#)]
- 2007 – 2012: N. Paradiso: *Tomography and manipulation of quantum Hall edge channels*, PhD thesis, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy (with Prof. F. Beltram). [[thesis](#)] [[defense talk](#)]
- 2005 – 2006: M. Balboni: *Magnetic properties of Co nanostructures on patterned Si*, diploma thesis, University of Modena and Reggio Emilia, Italy (with Prof. L. Sorba). [[thesis](#)]
- 2005 – 2006: Y. Pramudya: *Alignment of InAs Quantum Dot on InGaAs Buffers*, diploma thesis, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy (with Prof. L. Sorba). [[thesis](#)]
- 2004 – 2005: G. B. Golinelli: *Morphology and composition of self-assembled InAs quantum dots grown on GaAs(001)*, diploma thesis, University of Modena and Reggio Emilia, Italy (with Prof. L. Sorba). [[thesis](#)]
- 2002 – 2003: A. Ballestrazzi: *Electronic and magnetic properties of metallic nanowires*, diploma thesis, University of Modena and Reggio Emilia, Italy (with Prof. L. Sorba). [[thesis](#)]
- 1992 – 1993: M. Kennedy: *Conductivity measurements on thin metallic double layers*, diploma thesis, University of Hannover, Germany (with Prof. Dr. M. Henzler). [[link](#)] [[thesis](#)]
- 1991 – 1992: J. Bange: *The electrical conductivity of oligoatomic epitaxial silver films on Si(111)*, diploma thesis, University of Hannover, Germany (with Prof. Dr. M. Henzler). [[link](#)] [[thesis](#)]

Research Activities:

My main research interest is the physics of low-dimensional systems. Using a combination of scanning probe microscopies and low-temperature magneto-transport, we investigate quantum effects (quantum Hall effect, weak localization, anisotropic magneto-transport, Josephson junctions) and surface phenomena relevant for applications (hydrogen storage, defect characterization, surface functionalization, metal intercalation) in III-V 2DEGs, graphene, and exfoliated few-layer black phosphorus.

Since 2015: Funded by an ERC project, we investigate the properties of phosphorene, a new two-dimensional platform for advanced materials. Few-layer phosphorene flakes are obtained from black phosphorus crystals via liquid-phase or mechanical exfoliation, characterized by microscopic and spectroscopic

techniques, and processed into Hall-bar devices for the study of quantum effects like weak localization.

Related projects: ERC grant Phosfun (M. Peruzzini), SNS internal project SNS16_B_HEUN_004155, CNR travel grants for G. Gervais

Related publications: Hemsworth 2016, Serrano-Ruiz 2016

Related invited talks: Rome 2016

Since 2010: As part of the Graphene Flagship project, my group explores the use of graphene for hydrogen storage. Both physisorption and chemisorption are studied. Physisorption of hydrogen is enhanced by graphene functionalization with metal adatoms (Ti and Li) and defect engineering. Chemisorption is controlled by external parameters like graphene curvature and applied electric fields. Also hydrogen intercalation in epitaxial graphene is investigated. We use a variable temperature scanning tunnelling microscope (VT-STM) which operates in ultra high vacuum (UHV) which allows to characterize modified graphene samples and to study their interaction with hydrogen at the atomic level.

Related projects: Graphene Flagship, COST Action MP1103, Bilateral projects CNR – NRF South Korea, CNR – JSPS Japan, COST travel grants

Related publications: Chen 2016, Takahashi 2016, Mashoff 2015, Murata 2014, Mashoff 2013, Goler 2013

Related invited talks: NanoTech 2016, Seoul 2016, FisMat 2015, NSS8 2014, ICN+T 2014

Since 2007: We study interference phenomena as a fundamental manifestation of the quantum mechanical nature of electrons. Two-dimensional electron systems (2DES) in the quantum Hall (QH) regime are especially suited for this purpose given the large electronic coherence length characteristic of edge-channel chiral transport. In order to address these issues we are exploring the use of scanning gate microscopy (SGM) to control the trajectory and interaction of edge channels. The experiments are performed in a low temperature (300 mK) AFM/STM system operating in magnetic fields up to 9 T.

Related projects: FIRB Giovannetti, FIRB Beltram, Bilateral projects Italy – Poland, Italy – Quebec, CNR – CNRS France, CNR – RFBR Russia

Related publications: Xiang 2016, Mrenca-Kolasinska 2016, Bennaceur 2015, Iagallo 2015, Miseikis 2015, Iagallo 2013, Heun 2012, Paradiso 2012, Paradiso 2011, Salfi 2011, Paradiso 2010

Related invited talks: UNAM 2016, QNet 2014, Otranto 2014, CNRS 2013, Lithuania 2011

2004 – 2007: During my time at the TASC lab in Trieste, I investigated the physics of semiconductor quantum dots and rings. The model systems are InAs/GaAs and Ge/Si. Samples were grown by molecular beam epitaxy. Composition, valence band alignment, and work function of individual quantum dots were investigated by synchrotron radiation x-ray photoemission electron microscopy (XPEEM). On the other hand, part of my time was dedicated to instrumental development. I was heavily involved in the construction of a low temperature (4 K) scanning tunneling microscope (STM) operating in ultra high vacuum, which is operational since mid-2006.

Related projects: PRIN Tosatti, FIRB Modesti, CNR travel grant for F. Rosei

Related publications: Moutanabbir 2012, Biasiol 2011, Baranwal 2009, Schmidt 2009, Biasiol 2009, Ratto 2008, Mlakar 2008, Schmidt 2007,

Robinson 2007, Heun 2007, Clausen 2006, Ratto 2006, Biasiol 2005, Schmidt 2005, Ratto 2005, Ratto 2004

Related invited talks: Leoben 2009, Delmenhorst 2008, IUMRS-ICEM 2008, NanoE3 2007, Iconsat 2006, Pacificchem 2005, Manchester 2005

1997 – 2004: As a beam line scientist at Sincrotrone Trieste I was involved in the development of techniques for laterally resolved synchrotron radiation photoelectron spectroscopy and photoelectron diffraction. Responsible for the operation of the spectromicroscope SPELEEM (imaging microscope). Additional experience with the ESCA-microscope (using Fresnel zone plates) and the Spectromicroscope (using Schwarzschild optics). Spectromicroscopic investigations of low-dimensional systems: (1) Investigation of the mechanisms that induce nanoscopic pattern formation (self-organization). (2) In collaboration with the Japanese Telecom NTT I investigated the electronic structure of aligned carbon nanotubes by cross-sectional photoelectron spectromicroscopy. (3) Studied the properties of nanopatterns created by local anodic oxidation with an atomic force microscope and by dip pen nanolithography by spatially resolved photoelectron spectroscopy. (4) Studied the structural and magnetic phase transition in MnAs/GaAs epitaxial films by LEEM and XMCD-PEEM.

Related projects: (3) Bilateral projects Italy – India

Related publications: (1) Meyer zu Heringdorf 2001; (2) Suzuki 2006, Suzuki 2005, Suzuki 2004, Suzuki 2002, Suzuki 2001; (3) Radha 2012, Heun 2010, Bhuvana 2009, Vijaykumar 2008, Ercolani 2008, John 2007, Lazzarino 2006, Mori 2006, Mori 2005, Heun 2005, Ercolani 2005, John 2005, Gundiah 2004, Lazzarino 2003, Lazzarino 2002; (4) Engel-Herbert 2006, Daeweritz 2006, Daeweritz 2005. Bauer 2002

Related invited talks: (3) Las Vegas 2011, Belgaum 2010, Tsukuba 2005, Brookhaven 2004, NSS2 2002

1995 – 1997: As a TMR Marie Curie research fellow at Laboratorio TASC-INFN I was working on interfacial engineering of heterostructure interfaces to improve the growth of II-VI semiconductors on III-V substrates. I have grown the films (ZnSe on (In)GaAs) in a RIBER MBE 32-P machine. Characterization techniques employed include TEM, AFM, PL, RHEED, Nomarski optical microscopy, and XPS.

Related publications: Carlino 2000, Mueller 1999, Heun 1999, Mueller 1998, Heun 1998, Torrelles 1998, Heun 1997, Bonard 1997, Heun 1996

1993 – 1995: Working at the NTT Interdisciplinary Research Laboratories I have investigated the surface passivation of III-V semiconductors using synchrotron radiation photoelectron spectroscopy at the NTT beamline in the Photon Factory, Tsukuba, Japan. Sample growth in a chamber directly connected to the beamline. Additional measurements with RHEED, SEM, AFM, XPS, XRD, and TEM.

Related publications: Heun 1996, Oshima 1996, Maeyama 1996, Heun 1995, Sugiyama 1995, Maeyama 1995, Heun 1994

1990 – 1993: For my Ph.D. Thesis I performed measurements of the electrical properties of thin metal films (Ni, Ag, Pb, Au) in UHV at low temperatures (LHe) in high magnetic fields (8 T). Investigation of low-dimensional effects such as percolation, quantum size effect, weak localization, metal insulator transition. Films grown on Si(111) by MBE in the same UHV chamber. Structural

properties of the films determined by SPA-LEED, STM, SEM, and XRD, and correlated to the transport data.

Related publications: Luo 1994, Heun 1993, Schad 1992, Jentsch 1991

1988 – 1989: During my diploma thesis I investigated the structure and performed defect characterization of MBE grown thin films of silicon on Si(100) by means of spot profile analysis of LEED (SPA-LEED) in UHV; additional measurements with AES, SEM, and STM.

Related publications: Heun 1991

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA MBE DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL'ISTITUTO NANOSCENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL "Progetto infrastrutture PASQUA" CUP B55J19000360001, IMPORTO COMPLESSIVO € 1.050.000,00

CIG – 8648445A94

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto Stefan Heun, nato a ~~#####~~ con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente **effettivo o supplente** della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici:
 - Assing S.p.A. con sede legale in Via Edoardo Amaldi 15, 00015 Monterotondo (RM) codice fiscale 06725640582 partita IVA 01603091008;
- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) L'assenza¹ delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data 26/04/2021

Firma

¹ Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse) Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Silvia Rubini

Born :

Nationality: Italian

Address: IOM-CNR AREA Science Park, SS 14 Km 163.5 I-34149 TRIESTE

Present position

Senior Scientist at Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

In charge of the Molecular Beam Epitaxy laboratory at IOM CNR Institute, Trieste

<https://www.iom.cnr.it/research-facilities/facilities-labs/synthesis-and-nano-fabrication/mbe/>

Previous appointments

- 1997-2020 Staff Scientist at Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

In charge of the Molecular Beam Epitaxy laboratory at IOM _CNR Institute, Trieste

<https://www.iom.cnr.it/research-facilities/facilities-labs/synthesis-and-nano-fabrication/mbe/>

- July 1995 - December 1996: Research fellow at Laboratorio TASC - INFN, Trieste.
"Crescita epitassiale e caratterizzazione di semiconduttori composti."
- January 1994 - June 1995: Research fellow at the Physics Department "A. Volta" of the University of Pavia (Italy)
- November - December 1993: Visitor scientist at the Institute of Experimental Physics of the Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL)(CH).
- January - October 1993: Angelo Della Riccia Foundation Fellow at the "Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire" (CECAM) of Paris Sud University (F) and at the "Sèction de Recherche en Metallurgie Physique" of the Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), Saclay (F).
- September 1988 - December 1992: Assistant at the Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL, CH), in the Institute of Experimental Physics.
- December 1987 - August 1988: Research fellow of the Donegani Foundation (NO) in collaboration with Montefluos at the Industrial Chemistry and Chemical Engineering Department of the Institute of Technology of Milan (Italy).

Education

- November 24th 1992: Ph. D. degree (Docteur ès Sciences) at the Physics Department of the Federal Institute of Technology of Lausanne (EPFL).
- 17 July 1987: Laurea in Physics at the University of Pavia. Graduation marks: 110/110 cum laude.

Scientific interests

Present field of interest: semiconductor nanowires, including the study of their growth mechanism, their structural and electronic properties, and their applications in novel devices.

Former fields of interest include: structural phase transformations in solids, nuclear magnetic resonance (NMR), atomistic simulations, semiconductor/semiconductor, metal/semiconductor and superconductor/semiconductor interfaces, and semiconductor quantum dots.

Expertises

Molecular beam epitaxy (MBE), x-ray photoemission spectroscopy (XPS), synchrotron radiation spectroscopy and microscopy, scanning electron microscopy.

Bibliometric Information

Author of more than 140 papers on international journals.

h-index 27 (Scopus), 25 (WoS), 30 (Google Scholar).

Research projects and fundings

- 2017-present

Molecular Beam Epitaxy growth of V-VI Topological Insulator Nanowires - TIN

Project funded by NFFA-MIUR: Progetto Strategico a valenza internazionale NFFA – Roadmap ESFRI €238.000

- 2018-present Responsible of Local Unit

Innovative Nanowire DEvice Design — INDEED

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) European Training Network 722176 € 258.061,32

- 2009-2011 Commercial contract with Sincrotrone Trieste S.r.l. in the frame of Legge 30/84 research project entitled: **“Sviluppo di sensori chimici per diagnostica ambientale e biologica basati su nano tubi e nanofili”** € 191.667

2007-2009 Co-responsible for Trieste unit of EUROCORES FoNe Collaborative

Research Project. SPICO (**Spin-coherent transport and control in quantum nanostructures**) € 107.500

- 2005 - Scientific responsible for a collaborative project between ISM-CNR e TASC-INFN-CNR on **“Crescita e caratterizzazione di eterostrutture magnetiche GaAs:Mn”** € 15.500 + one year fellowship.

Educational experience

From 2006 to 2014 and from 2018 to present, Faculty member of the PhD school in nanotechnology of the University of Trieste.

Thesis supervision

University of Trieste, **Ph.D. Thesis:**

- 2015 Valentina Zannier, Ph.D in Nanotechnology **“ZnSe nanowires by molecular beam epitaxy: growth mechanisms and properties”**

- 2012 Stefano Ambrosini, Ph.D in Nanotechnology “MBE growth of self assisted GaAs nanowires and their characterization”
- 2008 Fauzia Jabeen, Ph.D in Nanotechnology “III-V semiconducting nanowires by molecular beam epitaxy”

University of Trieste, **Master Thesis:**

- 2018 Federico Berto, Master in Physics
“Gallium selenide nanostructure growth through catalytic decomposition of GaAs substrates during MBE growth”
- 2018 Anna deMonte, Master in Chemistry
“Crescita di Nanofili di semiconduttori III-V su substrati di Si(111) tramite Epitassia da Fasci Molecolari”
- 2014 Marco Vettori, Master in Chemistry “Nanofili di eterostrutture CdSe/ZnSe”
- 2013 Stefano Candeago, Master in Chemistry
“Parametri di Crescita e Proprietà di Nanofili di CdSe”
- 2013 Martina Morassi, Master in Chemistry
“Crescita di Nanofili di GaAs su substrati di Si(111) tramite Epitassia da Fasci Molecolari”
- 2013 Maria Manna, Master in Physics
“Studio delle proprietà di trasporto di nanofili di GaAs *self-catalizzati*”
- 2013 Marta Orrù, Master in Physics “Nanofili di GaAs drogati n tramite epitassia da fasci molecolari”
- 2012 Giacomo Priante, Master in Physics
“Growth of GaAs nanowires by Molecular Beam Epitaxy”
- 2011 Valentina Zannier, Master in chemistry
“Interazione substrato-catalizzatore nella crescita di nanofili semiconduttori composti”
- 2009 Stefano Ambrosini, Master in Physics
“Growth and characterization of semiconductor nanowires”
- 2006 Cristina Sambo, Master in Physics
“Crescita e caratterizzazione di punti quantici di In(As,N) in Ga(As,N)”
- 2001 Matteo Piccin, Master in Physics
“Proprietà delle giunzioni metallo-nitrato di gallio”
- 1996 Erica Milocco, Master in Physics:
“Transitività delle discontinuità di banda in eterostrutture II-VI/III-V”
- 1995 Roberta Lantier, Master in Physics:
“Sviluppo di nuovi sistemi II-VI/III-V con adattamento reticolare ideale”

University of Trieste, **Diploma Thesis:**

- 2018 Carlo Federico Pauletti, Diploma in Physics “
- 2012 Elisa Salatin, Diploma in Physics “Formazione e caratterizzazione di nanoparticelle di Mn per la crescita di nanofili semiconduttori”
- 2010 Blaz Gosparini, Diploma in Physics

“Studio della nucleazione di nanofili di GaAs su substrati di GaAs/Si”

•2010 Anna Tararan, Diploma in Physics

“Deposizione e caratterizzazione di nanoparticelle di Au su GaAs(111)B”

International Center of Theoretical Physics (ICTP) Trieste

2004 F. Jabeen, Diploma course in Condensed matter physics “Growth and characterisation of InAs(N) Quantum Dots on GaAs by MBE”

Member of Evaluation Committee for PhD Thesis:

- Université de Lille (F) 25.11.2016, Adrian Diaz Alvarez, “Surface Characterization of III-V semiconductor nanowires: morphological, structural and electronic properties”
- Université Grenoble Alpes (F) 26.09.2017, Marta Orrù, “Nanofils semiconducteurs, vers des objets magnetiques ultimes, mecanisme de croissance”
- Université Paris-Saclay, (F) 17.09.2018, Martina Morassi “Croissance de nanofils InGaN pour la récupération des énergies photovoltaïques et piézoélectriques”

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA MBE DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL'ISTITUTO NANOSCENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL "Progetto infrastrutture PASQUA" CUP B55J19000360001, IMPORTO COMPLESSIVO € 1.050.000,00

CIG – 8648445A94

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

la sottoscritta Silvia Rubini, (...omissis...), con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente **effettivo o supplente** della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici:
 - Assing S.p.A. con sede legale in Via Edoardo Amaldi 15, 00015 Monterotondo (RM) codice fiscale 06725640582 partita IVA 01603091008;
- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) L'assenza¹ delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data 26/04/2021

Firma

¹ **Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse)** Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, intervenga nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.



Curriculum Vitae et studiorum

Personal information

First name / Surname

VALENTINA ZANNIER

Work experience

Dates	August 2020 – Ongoing
Occupation or position held	CNR Researcher – permanent position (Bando 366.54 – Provvedimento DG del 1/7/2020 – Prot. 0001701/2020 del 17/07/2020)
Main activities and responsibilities	Growth of III-V semiconductor nanostructures by Chemical Beam Epitaxy.
Name and address of employer	Istituto Nanoscienze – CNR, Laboratorio NEST – Scuola Normale Superiore Piazza S. Silvestro 12 56127 Pisa, Italy
Type of business or sector	Research and development
Dates	August 2018 – July 2020
Occupation or position held	Researcher (Bando NANO 002- 2018 PI – prot. NANO n. 638 del 12/3/2018)
Main activities and responsibilities	Growth of III-V semiconductor nanostructures by Chemical Beam Epitaxy for electronic and optoelectronic devices.
Name and address of employer	Istituto Nanoscienze – CNR, Laboratorio NEST – Scuola Normale Superiore Piazza S. Silvestro 12 56127 Pisa, Italy
Type of business or sector	Research and development
Dates	January 2015 – July 2018
Occupation or position held	Post-doctoral fellow (Bando n° NANO AR 021/2014 PI – prot. n° 0005118 del 10/9/2014– atto di conferimento n. 0006105 del 24/10/2014)
Main activities and responsibilities	Growth of III-V semiconductor nanowires and related heterostructures by Chemical Beam Epitaxy. Their characterization by means of microscopic and spectroscopic techniques.
Name and address of employer	Istituto Nanoscienze – CNR, Laboratorio NEST – Scuola Normale Superiore Piazza S. Silvestro 12 56127 Pisa, Italy
Type of business or sector	Research and development
Dates	August 2011 – December 2014
Occupation or position held	Research activity (Bando n° IOM BS 001/2011 TS – prot. IOM – CNR n. 2011 del 6/6/2011 – atto di conferimento n. 0002760 del 3/8/2011, and PhD scholarship from University of Trieste)
Main activities and responsibilities	Growth of semiconductor nanowires by means of Molecular Beam Epitaxy and their characterization by means of scanning electron microscopy, X-ray photoemission spectroscopy, reflection of high energy electron diffraction, X-ray diffraction, photoluminescence.

Name and address of employer	Istituto Officina dei Materiali (IOM - CNR) Area Science Park – Basovizza Strada Statale 14 Km 163,5 34149 Trieste, Italy
Type of business or sector	Research and development
Dates	May 2010 – May 2011
Occupation or position held	Internship for Master Thesis
Main activities and responsibilities	Growth of ZnSe nanowires by means of Molecular Beam Epitaxy and their characterization: scanning electron microscopy and X-ray photoemission spectroscopy.
Name and address of employer	Istituto Officina dei Materiali (IOM - CNR) Area Science Park – Basovizza Strada Statale 14 Km 163,5 34149 Trieste, Italy
Type of business or sector	Research and development
Dates	October 2009 - January 2010
Occupation or position held	Tutor (Università degli Studi di Trieste, prot. n° 128/2009-III-1.2)
Main activities and responsibilities	Teaching and tutoring undergraduate students during chemical laboratory lessons.
Name and address of employer	University of Trieste Piazzale Europa, 1 34127 Trieste, Italy
Type of business or sector	University and education
Dates	May 2008 – September 2008
Occupation or position held	Internship for first level degree thesis
Main activities and responsibilities	Characterization of condensed matter systems by means of Nuclear Magnetic Resonance
Name and address of employer	University of Trieste – Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche via Licio Giorgieri, 1 34127 Trieste, Italy
Type of business or sector	Research and development

Education and training

<p>Dates</p> <p>Title of qualification awarded</p> <p>Principal subjects/occupational skills covered</p> <p>Name and type of organisation</p>	<p>2012 – 2015</p> <p>PhD in Nanotechnology</p> <p>Growth and characterization of semiconductor nanowires by means of Molecular Beam Epitaxy Thesis title: <i>"ZnSe nanowires by molecular beam epitaxy: growth mechanisms and properties"</i></p> <p>University of Trieste, Italy IOM – CNR Trieste, Italy Institut Néel and CEA Grenoble, France (period abroad from May to July 2014)</p>
<p>Dates</p> <p>Title of qualification awarded</p> <p>Principal subjects/occupational skills covered</p> <p>Name and type of organisation providing education and training</p> <p>Level in national or international classification</p>	<p>2008 - 2011</p> <p>Master Degree in Chemistry</p> <p>Inorganic and physical chemistry (theory and laboratory). Supramolecular and nanostructured systems Thesis title: <i>"Substrate – catalyst interaction and its effect on the growth of semiconductor nanowires"</i></p> <p>University of Trieste, Italy IOM – CNR Trieste, Italy</p> <p>110/110 cum laude</p>
<p>Dates</p> <p>Title of qualification awarded</p> <p>Principal subjects/occupational skills covered</p> <p>Name and type of organisation providing education and training</p> <p>Level in national or international classification</p>	<p>2005 – 2008</p> <p>First Level Degree in Chemistry</p> <p>Analytical, organic, inorganic and physical chemistry (theory and laboratory). Thesis title: <i>"Self – assembly of DDAB/bile salt cationic systems by means of multinuclear NMR"</i></p> <p>University of Trieste, Italy</p> <p>110/110 cum laude</p>
<p>Dates</p> <p>Title of qualification awarded</p> <p>Principal subjects/occupational skills covered</p> <p>Name and type of organisation providing education and training</p> <p>Level in national or international classification</p>	<p>2000 – 2005</p> <p>High School Diploma</p> <p>High School of Science and Technology</p> <p>ITI "A. Malignani", Udine, Italy</p> <p>100/100</p>

Personal skills and competences

Mother tongue(s) **Italian**

Other language(s) **English**

Self-assessment

European level ()*

Understanding		Speaking		Writing
Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
B2	B2	B2	B2	B2

(*) [*Common European Framework of Reference for Languages*](#)

Organisational skills and competences

- Good attitude in team working, time optimization and activity organization.
- Work experience in scientific and organizing committees for job positions and international conferences. Peer reviewing of international journals.

Technical skills and competences

- Epitaxial growth of semiconductor nanostructures by means of Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Chemical Beam Epitaxy (CBE).
- Characterization of semiconductor nanostructures by spectroscopic and microscopic techniques: x-ray photoemission spectroscopy (XPS), x-ray diffraction (XRD), reflection of high energy electron diffraction (RHEED), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX), photoluminescence (PL), cathodoluminescence (CL).
- Substrate preparation (cleaning, etching, metallic film deposition, drop casting of liquid solutions).
- Use of the common synthesis and characterization techniques in a chemical laboratory.

Awards

- 23/09/2019: Membership to the Organizing Committee of the Nanowire Week 2019 held in Pisa (Italy) co-organized by NANO-CNR and Scuola Normale Superiore
- 26/06/2018: *Invited talk* at the "3rd joint AIC-SILS" Conference held in Rome (Italy)
- 20/11/2017: *Invited talk* at the "Italian Crystal Growth 2017" meeting held in Milano (Italy) at the University of Bicocca
- 5/29/2017: *Invited talk* at the International Conference "Nanowire week" held in Lund (Sweden)
- 3/22/2017: *Invited talk* at the International Conference "European Workshop on Molecular Beam Epitaxy" held in Saint Petersburg (Russia)
- 12/5/2016: winner of the "Seed project award" of the "Istituto Nanoscienze – CNR" for young researchers
- 7/2/2016: winner of the "Best poster award" at the International workshop "Nanostructures for Photonics" held in Saint Petersburg (Russia)
- 1/27/2015: winner of the "Best PhD career award" of the PhD School in Nanotechnology – University of Trieste
- 3/3/2014: winner of an International mobility scholarship for PhD students, supported by the Italian Ministry of Foreign Affairs

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA MBE DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL'ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL "Progetto infrastrutture PASQUA" CUP B55J19000360001, IMPORTO COMPLESSIVO € 1.050.000,00

CIG – 8648445A94

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

La sottoscritta ZANNIER VALENTINA, nata a ~~09/06/1960~~ con riferimento alla gara di cui in oggetto ed a seguito della comunicazione inviata dal RUP contenente l'intenzione di codesta Direzione di procedere alla nomina quale componente **effettivo o supplente** della Commissione giudicatrice, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- 1) Di accettare l'incarico di cui trattasi;
- 2) Di uniformarsi ai principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" (di cui D.P.R. 16/4/2013, n. 62 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, in vigore dal 19 giugno 2013) nonché nel vigente "Codice di comportamento dei dipendenti CNR ai sensi dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001;
- 3) Di prendere atto che hanno presentato offerta i sottonotati operatori economici:
 - Assing S.p.A. con sede legale in Via Edoardo Amaldi 15, 00015 Monterotondo (RM) codice fiscale 06725640582 partita IVA 01603091008;
- 4) L'assenza¹ di conflitto di interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) L'assenza¹ delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché copia di un documento di identità in corso di validità, nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Data 26/04/2021

Firma

¹ Art. 42, comma 2 (Conflitto di interesse) Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n° 62.

Art. 77, commi 4, 5 e 6 (Commissione giudicatrice) 4 - I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 5 - Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6 - Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del C.P.C., nonché l'articolo 42 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 7, DPR 62/2013 (Obbligo di astensione) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 35-bis, D.LGS. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 51 C.P.C. (Astensione del giudice) Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.